Полуметаллические состояния кристаллического молекулярного водорода при высоких давлениях

Г. Э. *Норман*^{+*}, *И. М. Саитов*^{+*1)}

+ Объединенный институт высоких температур РАН, 125412 Москва, Россия

*Московский физико-технический институт (НИУ), 117303 Москва, Россия

Поступила в редакцию 2 декабря 2019 г. После переработки 23 декабря 2019 г. Принята к публикации 23 декабря 2019 г.

Получены полуметаллические состояния кристаллического молекулярного водорода при температуре 100 К в диапазоне давлений от 410 до 626 ГПа. Для анализа характера проводимости проводится расчет зонной структуры в рамках теории функционала плотности с использованием гибридного обменнокорреляционного функционала HSE (Heyd–Scuseria–Ernzerhof). Одно из полуметаллических состояний возникает в моноклинной структуре с симметрией C2/с при сжатии до давления 410 ГПа, при котором происходит закрытие щели между валентной зоной и зоной проводимости. Причем валентная зона является частично незаполненной, а зона проводимости – частично заполненной, что является характерным признаком *полуметалла*. При давлении 302 ГПа кристаллический молекулярный водород со структурой C2/с остается изолятором. Найдена зависимость электропроводности от давления для 300–500 ГПа. Второе полуметаллическое состояние наблюдается для ромбической структуры с симметрией Стса-4 при давлении 626 ГПа.

DOI: 10.31857/S0370274X20030078

Введение. Проблема металлизации кристаллического молекулярного водорода при повышении давления теоретически исследуется с 1935 г.; предполагалось, что молекулы водорода диссоциируют, образуя объемно-центрированную кубическую кристаллическую решетку с одним протоном в элементарной ячейке [1]. В русле этого предположения продолжены первопринципные теоретические подходы, основанные на теории функционала плотности (ТФП) [2–7] и квантовом методе Монте-Карло [8, 9], которые предсказывают возможность существования стабильной атомарной структуры кристаллического водорода в диапазоне давлений P == 370-500 ГПа. Было показано также, что вплоть до атмосферного давления атомарный металлический водород может существовать в метастабильном состоянии [10–12]. Первые экспериментальные указания на образование кристаллического металлического водорода предположительно были зафиксированы в работах [13, 14], при давлениях 495 и 425 ГПа соответственно.

Вместе с тем было обнаружено, что относительно высокие проводимости могут наблюдаться и в кристаллическом молекулярном водороде, т.е. в условиях, когда молекулы остаются недиссоциированными. Полученные значения удельного сопротивления кристаллического молекулярного водорода являются типичными для полуметаллов, в частности, для висмута [23, 24]. Это наталкивает на мысль, что молекулярные кристаллы водорода являются полуметаллами в указанных выше условиях. Однако зонная структура этих кристаллов не исследовалась. Этому вопросу посвящена настоящая работа. В сле-

Появился даже термин – металлический молекулярный водород. Возникновение и плавный рост электропроводности в фазе III молекулярного водорода получены при расчете в рамках ТФП и квантового метода Монте-Карло в работах [15-22]. При этом согласно [2] структура водорода в фазе III при давлениях $P > 200 \,\Gamma\Pi a$ является моноклинной с симметрией С2/с с 12-ю атомами в элементарной ячейке. Согласно оценкам, полученным в работах [15–20], образование металлического молекулярного водорода возможно при давлении $P = 250 - 500 \,\Gamma \Pi a$. В расчетах [2, 6, 16, 17, 20] найдено, что металлический молекулярный водород имеет ромбическую структуру с симметрией Cmca с 4-мя атомами в элементарной ячейке. Структура Cmca-4 является устойчивой при давлениях выше 440 ГПа. Она возникает также как структура метастабильного проводящего молекулярного водорода при давлениях выше 515 ГПа при сжатии вдоль изотермы 100 К [21, 22].

¹⁾e-mail: saitovilnur@gmail.com

дующем разделе изложен использованный теоретический подход в рамках квантового молекулярнодинамического моделирования и метода ТФП. Затем рассматриваются структуры кристаллического молекулярного водорода, полученные в работе [22] при сжатии вдоль изотермы 100 К: моноклинная структура с симметрией C2/с и ромбическая структура с симметрией С2/с и ромбическая структуры и электропроводность позволяют отнести их к полуметаллам. Рассмотрен диапазон давлений P = 302-626 ГПа. В заключительном разделе приведены результаты расчета зависимости электропроводности от давления для структуры C2/с.

Метод расчета. Расчеты электронных свойств кристаллических структур молекулярного водорода проводятся в рамках ТФП. Используется пакет VASP [25–28]. Расчеты проводятся в области плотностей водорода от 1.14 до $1.562 \,\mathrm{r/cm^3}$ при температуре 100 K, соответствующей диапазону давлений $P = 302-626 \,\Gamma \Pi a$ согласно [22]²).

Волновые функции – электронные орбитали, являющиеся решением системы уравнений Кона-Шема, и соответствующие им уровни энергии определяют основное состояние рассматриваемой системы при заданной конфигурации атомов и температуре. Заселенность электронных орбиталей определяется функцией распределения Ферми-Дирака с размытием, соответствующим электронной температуре. Решение системы уравнений Кона-Шема находится в базисе плоских волн с параметром обрезания, равным 1200 эВ, что позволяет достичь сходимости результатов расчета. Используется обменно-корреляционный функционал HSE (Heyd–Scuseria–Ernzerhof) [29], обменная часть которого содержит три четверти обмена функционала PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof) [30] и четверть обмена Хартри-Фока, что позволяет более точно рассчитывать величину щели между валентной зоной и зоной проводимости. Электрон-ионное взаимодействие описывается посредством потенциала спроектированных присоединенных волн.

Рассматриваются две структуры кристаллического молекулярного водорода: моноклинная с симметрией C2/с с 12-ю атомами в элементарной ячейке и ромбическая с симметрией Стса с 4 атомами в элементарной ячейке. Расчеты зонной структуры и электропроводности проводятся для ячеек с 12-ю атомами в структуре с симметрией C2/с и 8-ю атомами в структуре с симметрией Стса, находящимися в периодических граничных условиях. Электропроводность рассчитывается по формуле Кубо– Гринвуда [31, 32]. Для расчета зонной структуры и электропроводности задается сетка из $12 \times 12 \times 12$ **k**точек с применением схемы Monkhorst–Pack [33], что обеспечивает сходимость результатов расчета.

Моноклинная структура с симметрией C2/с. Молекулярно-динамическое моделирование водорода в рамках ТФП [22] показало устойчивость моноклинной структуры C2/с при значениях плотности от 1.14 до 1.45 г/см³, что соответствует диапазону давлений P = 302-515 ГПа. Элементарная ячейка структуры C2/с, содержащей 12 атомов водорода, сгруппированных в 6 молекул, и рассчитанное распределение электронной плотности при значении давления 302 ГПа представлены на рис. 1. Диапазон значений пространственного распреде-



Рис. 1. (Цветной онлайн) Структура элементарной ячейки с симметрией C2/с при плотности 1.14 г/см³: (а) – пространственное расположение атомов в элементарной ячейке, атомы в молекулах соединены для наглядности, задние атомы изображены зеленым; (b) – распределение электронной плотности в передней плоскости элементарной ячейки в диапазоне значений от 0.3 до 2.6 Å⁻³, шкала равномерная

ления электронной плотности, представленного на рис. 1b, от 0.3 до 2.6 Å^{-3} . Наименьшее расстояние между атомами на рис. 1a равно 0.75 Å, что достаточно близко к межатомному расстоянию 0.74 Å в молекуле водорода H_2 . Профиль распределения электронной плотности также явно указывает на молекулярный характер структуры водорода при давлении $302 \Gamma\Pi a$.

Зонная структура при плотности $1.14 \,\mathrm{r/cm^3}$ и давлении $302 \,\Gamma \Pi$ а представлена на рис. 2. Значения энергии E отсчитываются от энергии Ферми E_f . Видно, что профиль зонной структуры имеет щель между валентной зоной и зоной проводимости. При этом значения прямой и непрямой щели равны соответственно 2.587 и 1.855 эВ. Таким образом, размер щели заметно превышает величину температу-

²⁾Первичной в нашем расчете является концентрация молекул, т.е. плотность, поэтому значения давления оказываются не круглыми.



Рис. 2. (Цветной онлайн) Зонная структура при давлении 302 ГПа. Красные линии соответствуют зоне проводимости, синие линии – валентной зоне. Сплошные линии – результаты расчетов, полученные для обменно-корреляционного функционала HSE, пунктирные – функционал PBE

ры kT = 0.0086 эВ, что обуславливает низкую проводимость. На рисунке 2 также приведено сравнение с результатами расчета с использованием обменнокорреляционного функционала РВЕ (пунктирные линии). При этом величины прямой и непрямой щели равны 1.065 и 1.816 зВ соответственно. Как можно заметить, использование функционала РВЕ приводит к меньшей величине щели между зонами проводимости и валентности.

Как видно из рис. 3, при увеличении давления до 410 ГПа структура молекулярного твердого водорода



Рис. 3. (Цветной онлайн) Распределение электронной плотности структуры с симметрией C2/с в диапазоне значений от 0.8 до 0.9 Å⁻³ при различных значениях давления: (a) – 302 ГПа; (b) – 410 ГПа

остается моноклинной с симметрией C2/с. При этом происходит возрастание значений электронной плотности в седловых точках между молекулами, что должно привести к резкому увеличению электропроводности по сравнению с давлением 302 ГПа.

Результаты расчета зонной структуры при плотности $1.3 \,\mathrm{r/cm^3}$ и давлении 410 ГПа представлены на рис. 4. При сжатии возникает перекрытие зоны проводимости и валентной зоны, при котором валентная зона является частично незаполненной и за этот счет зона проводимости оказывается частично заполнен-





Рис. 4. (Цветной онлайн) Зонная структура при давлении 410 ГПа. Цвет линий как на рис. 2. Электронные и дырочные "карманы" выделены штриховкой

ной. Величина перекрытия зон 0.4 эВ. Как было упомянуто ранее, полученный профиль зонной структуры является характерным для полуметалла.

Ромбическая структура с симметрией Стса-4. Согласно результатам [21, 22] при значении плотности 1.45 г/см³ и давлении 515 ГПа происходит изменение структуры молекулярного водорода с моноклинной на ромбическую с группой симметрии Cmca с 4-мя атомами в элементарной ячейке. Такая структура молекулярного водорода является метастабильной и существует согласно результатам [22] в диапазоне давлений $P = 515-626\,\Gamma\Pi a$ при температуре 100 К. В этом диапазоне давлений электропроводность заметно больше в сравнении с C2/с и возрастает до значения 1200 $(OM \cdot CM)^{-1}$ при давлении 626 ГПа. Элементарная ячейка и распределение электронной плотности в структуре Стса-4 при значении плотности 1.562 г/см³ и давлении 626 ГПа представлены на рис. 5. Ближайшее



Рис. 5. (Цветной онлайн) Структура элементарной ячейки с симметрией Стса при плотности $1.562\,\mathrm{r/cm^3}$: (a) – пространственное расположение атомов; (b) – распределение электронной плотности в диапазоне значений от 0.3 до $2.6\,\mathrm{\AA^{-3}}$

расстояние между атомами в этой структуре возрастает до значения 0.78 Å, при этом водород остается

молекулярным, что подтверждается распределением электронной плотности, представленным на рис. 5b.

Как видно из рис. 6, в структуре Сmca-4 при давлении 626 ГПа возникает перекрытие валентной зоны



Рис. 6. (Цветной онлайн) Зонная структура при давлении 626 ГПа

и зоны проводимости, причем валентная зона оказывается частично незаполненной, а дно зоны проводимости – частично заполненным, так же, как и в случае моноклинной структуры с симметрией C2/с при давлении 410 ГПа. Таким образом, кристаллический молекулярный водород со структурой Стса-4 также является полуметаллом. Величина перекрытия зон проводимости и валентности 4 эВ, что на порядок больше, чем для структуры C2/с. Поэтому значения электропроводности близки к металлическим. Без анализа зонной структуры можно было бы сделать вывод о металлическом характере проводимости данной структуры, как это предсказывалось в работах [2, 6, 16, 17, 20].

Электропроводность. Для полуметаллов характерно наличие некоторой щели между зоной проводимости и валентной зоной по всем направлениям вектора k в зоне Бриллюэна. При этом, однако, происходит перекрытие валентной зоны в одном или нескольких секторах вектора k с зоной проводимости в одном или нескольких других секторах вектора k. Вследствие этого электроны, оказавшиеся в валентной зоне выше уровня Ферми, "перетекают" в области зоны проводимости, оказавшиеся ниже уровня Ферми. Образующиеся при этом дырочный "карман" или "карманы" в валентной зоне и электронный "карман" или "карманы" в зоне проводимости являются признаками полуметалла. Такой вид зонной структуры полуметалла отличает его от металла, где валентная зона заполнена полностью [23, 34–41]. Объемы электронных и дырочных "карманов" определяют величину электропроводности полуметалла [34, 35].

Для кристаллического молекулярного водорода в случае моноклинной структуры с симметрией $\rm C2/c$

при давлении 302 ГПа щель между зоной проводимости и валентной зоной сохраняется (рис. 2), что обуславливает низкое значение $0.58 \, (\text{Ом} \cdot \text{см})^{-1}$ полученной нами электропроводности. При увеличении давления до 410 ГПа картина уже соответствует полуметаллу. Профиль зонной структуры, представленный на рис. 4, согласуется с результатами для других полуметаллов [39–41]. Изменение распределения электронной плотности (рис. 3) приводит к увеличению электропроводности до значений $12.7 \, (OM \cdot CM)^{-1}$, что более чем на порядок больше значения при давлении 302 ГПа. Значения электропроводности, полученные при давлении 410 ГПа, являются типичными для полуметаллов, в частности, для висмута [23, 24]. Для структуры Cmca-4 "карманы" заметно больше, чем для С2/с в силу большего перекрытия (рис. 6), и, соответственно, проводимость приближается по величине к металлической, оставаясь по своей природе полуметаллической.

Результаты расчетов электропроводности для структуры с симметрией C2/с при четырех давлениях представлены на рис. 7. Видно, что при переходе к полуметаллическому состоянию рост электропроводности становится экспоненциальным.



Рис. 7. (Цветной онлайн) Зависимость электропроводности от давления при температуре 100 К: черные кружки, соединенные пунктиром для наглядности, – результаты расчета, красные кресты – эксперимент [42]

На существование полуметаллического состояния кристаллического молекулярного водорода указывают результаты недавних экспериментов Еремца и др. [42], в которых исследованы зависимости удельного сопротивления и профилей рамановского спектра при температурах ниже 200 К и давлениях P == 195–480 ГПа, что соответствует области существования фазы III. Найденная зависимость удельного сопротивления от температуры имеет минимум в диапазоне давлений $P = 350-440\,\Gamma\Pi a$, что указывает на то, что кристаллический молекулярный водород в заданном диапазоне давлений является полуметаллом. На рамановском спектре при давлениях выше 440 ГПа происходит исчезновение пика, соответствующего молекуле водорода. По мнению авторов [42], это может служить указанием на дальнейшее преобразование как в хороший молекулярный металл, так и в атомное состояние. Результаты [42] согласуются с экспериментальными данными [43] при давлении 360 ГПа, также указывающими на полуметаллический характер проводимости кристаллического молекулярного водорода. Однако, согласно расчетам [17], состояние молекулярного водорода, исследуемое в [43], соответствует ромбической структуре с симметрией Стса с 12-ю частицами в элементарной ячейке.

Результаты измерений [42] также представлены на рис. 7. Видно, что результаты расчета достаточно хорошо согласуются с экспериментальными данными как по абсолютной величине, так и по относительной зависимости электропроводности от давления.

Выводы. В рамках теории функционала плотности проведен расчет зонной структуры и электропроводности кристаллического молекулярного водорода при температуре 100 К. Рассмотрены две структуры: моноклинная решетка с симметрией C2/с с 12-ю атомами в элементарной ячейке при значениях давлений $P = 302 - 515 \Gamma \Pi$ а и ромбическая решетка с симметрией Стса с 4 атомами в элементарной ячейке при давлениях $P = 515-626 \Gamma \Pi$ а. Сделаны следующие выводы.

1. При давлении 302 ГПа кристаллический молекулярный водород со структурой C2/с является изолятором.

2. При сжатии структуры C2/с до давления 410 ГПа возникает полуметаллическое состояние, где наблюдается перекрытие зоны проводимости и валентной зоны на уровне Ферми, причем валентная зона оказывается частично незаполненной при частично заполненной зоне проводимости.

3. Рост электропроводности в интервале давлений 340–500 ГПа близок к экспоненциальному. Результаты расчета согласуются с недавними измерениями [42], выполненными для 350–440 ГПа, как по абсолютной величине, так и по относительной зависимости.

4. Предсказано полуметаллическое состояние кристаллического молекулярного водорода с ромбической структурой с симметрией Стса при давлениях около 626 ГПа. Авторы благодарят В.В.Бражкина за полезные советы. Расчеты проведены на кластерах МСЦ РАН и кластере К-100 ИПМ им. М.В.Келдыша РАН. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда по гранту # 18-19-00734.

- E. Wigner and H. B. Huntington, J. Chem. Phys. 3, 764 (1935).
- C. J. Pickard and R. J. Needs, Nature Phys. 3, 473 (2007).
- J. M. McMahon and D. M. Ceperley, Phys. Rev. Lett. 106, 165302 (2011).
- Н. Н. Дегтяренко, Е. А. Мазур, Письма в ЖЭТФ 104(5), 329 (2016).
- Н. А. Кудряшов, А. А. Кутуков, Е. А. Мазур, Письма в ЖЭТФ **104**(7), 488 (2016).
- Н. Н. Дегтяренко, Е.А. Мазур, К.С. Гришаков, Письма в ЖЭТФ 105(10), 624 (2017).
- Н. А. Кудряшов, А. А. Кутуков, Е. А. Мазур, Письма в ЖЭТФ 105(7), 424 (2017).
- S. Azadi, B. Monserrat, W. M. C. Foulkes, and R. J. Needs, Phys. Rev. Lett. **112**, 165501 (2014).
- J. McMinis, R.C. Clay, D. Lee, and M.A. Morales, Phys. Rev. Lett. **114**, 105305 (2015).
- 10. N.W. Ashcroft, Phys. Rev. Lett. 21, 1748 (1968).
- Е. Г. Бровман, Ю. Каган, А. Холас, ЖЭТФ 62, 1492 (1972).
- Ю. Каган, Е.Г. Бровман, А. Холас, ЖЭТФ 73, 967 (1977).
- 13. R. Dias and I. F. Silvera, Science 355, 715 (2017).
- P. Loubeyre, F. Occellil, and P. Dumas, arXiv 1906.05634 (2019).
- K. A. Johnson and N. W. Ashcroft, Nature 403, 632 (2000).
- A.F. Goncharov, J.S. Tse, H. Wang, J. Yang, V.V. Struzhkin, R. T. Howie, and E. Gregoryanz, Phys. Rev. B 87, 024101 (2013).
- S. Azadi, W. M. C. Foulkes, and T. D. Kühne, New J. Phys. 15, 113005 (2013).
- S. Azadi, N. D. Drummond, and W. M. C. Foulkes, Phys. Rev. B 95, 035142 (2017).
- S. Azadi, R. Singh, and T.D. Kuehne, J. Comput. Chem. **39**, 262 (2018).
- G. Rillo, M. A. Morales, D. M. Ceperley, and C. Pierleoni, J. Chem. Phys. **148**, 102314 (2018).
- 21. Г.Э. Норман, И.М. Саитов, ДАН 485(6), 676 (2019).
- 22. И. М. Саитов, Письма в ЖЭТФ **110**(3), 184 (2019).
- Е.А. Дорофеев, Л.А. Фальковский, ЖЭТФ 87(6), 2202 (1984).
- P. Brown, K. Semeniuk, A. Vasiljkovic, and F. MGrosche, Phys. Proceedia 75, 29 (2015).

Письма в ЖЭТФ том 111 вып. 3-4 2020

- 25. G. Kresse and J. Hafner, Phys. Rev. B ${\bf 47},\,558$ (1993).
- 26. G. Kresse and J. Hafner, Phys. Rev. B 49, 14251 (1994).
- G. Kresse and J. Furthmuller, Phys. Rev. B 54, 11169 (1996).
- G. Kresse and J. Furthmüller, Comput. Mater. Sci. 6, 15 (1996).
- J. Heyd, G.E. Scuseria, and M. Ernzerhof, J. Chem. Phys. **118**, 8207 (2003).
- J. P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77(18), 3865 (1996).
- 31. R. Kubo, J. Phys. Soc. Jpn. 12, 570 (1957).
- 32. D.A. Greenwood, Proc. Phys. Soc. 71, 585 (1958).
- H. J. Monkhorst and J. D. Pack, Phys. Rev. B 13, 5188 (1976).
- Дж. Займан, Принципы теории твердого тела, Мир, М. (1974), 472 с.

- Н. Ашкрофт, Н. Мермин, Физика твердого тела, Мир, М. (1979), т. 1, 399 с.
- Б. А. Волков, Л. А. Фальковский, ЖЭТФ 85(6), 2135 (1983).
- 37. Л. А. Фальковский, УФН **149**(2), 336 (1986).
- 38. Л. А. Фальковский, ФТТ **28**(1), 270 (1986).
- 39. X.G. Wan, A.M. Turner, A. Vishwanath, and S.Y. Savrasov, Phys. Rev. B 83, 205101 (2011).
- H. Weng, C. Fang, Z. Fang, B. A. Bernevig, and X. Dai, Phys. Rev. X 5, 011029 (2015).
- C. Shekhar, A. K. Nayak, Y. Sun et al. (Collaboration), Nature Phys. 11, 645 (2015).
- M. I. Eremets, A. P. Drozdov, P. P. Kong, and H. Wang, Nature Phys. (2019); doi: 10.1038/s41567-019-0646-x.
- C.-S. Zha, Z. Liu, and R. J. Hemley, Phys. Rev. Lett. 108, 146402 (2012).